

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 20 年 2 月 14 日 (2008.2.14)

【公表番号】特表 2007-520891 (P2007-520891A)

【公表日】平成 19 年 7 月 26 日 (2007.7.26)

【年通号数】公開・登録公報 2007-028

【出願番号】特願 2006-552133 (P2006-552133)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 27/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/12 E

H 0 1 L 27/12 D

H 0 1 L 27/08 3 3 1 E

H 0 1 L 27/08 1 0 2 B

H 0 1 L 29/78 6 2 6 C

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 12 月 25 日 (2007.12.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

頂部面を有する活性領域を備えた基板を提供する工程と、
 酸素リッチ型半導体材料層からなる第一の層を、前記頂部面上に形成する工程と、
 前記第一の層に、半導体材料層からなる第二の層を直接的にエピタキシャル成長させる
 工程と、
 前記第一の層を半導体酸化物の層に変換する工程と、
 そのチャネルが前記第二の層にのみ形成されているトランジスタを形成する工程と、
 からなる方法。

【請求項 2】

前記トランジスタの深いソース及び深いドレインは前記第二の層においてのみ形成され
 ている、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

頂部面を有する活性領域を備えた基板を提供する工程と、
酸素リッチ型半導体材料層からなる第一の層を、前記頂部面上に形成する工程と、
前記第一の層に、半導体材料層からなる第二の層を直接的にエピタキシャル成長させる
工程と、
前記第一の層を半導体酸化物の層に変換する工程と、
前記第二の層にゲート誘電体を形成する工程と、
 からなり、前記ゲート誘電体と前記第二の層との間には半導体層が存在していない、方法

【請求項 4】

前記ゲート誘電体は、前記第二の層上に直接的に形成される、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

頂部面を有する活性領域と、第一の分離領域と、第二の分離領域と、を備えた基板を提供する工程と、

前記第一の分離領域と前記第二の分離領域との間であって、かつ前記頂部面上に酸素リッチ型半導体材料層からなる第一の層を選択的に形成する工程と、

前記第一の分離領域と前記第二の分離領域との間にある前記第一の層上に、半導体材料層からなる第二の層を直接的かつ選択的にエピタキシャル成長させる工程と、

前記第一の層を半導体酸化物の層に変換する工程と、

からなり、前記第二の層は前記第一の分離領域及び前記第二の分離領域には形成されていない、方法。